МГТУ им. Н. Э. Баумана

И. Н. ФЕТИСОВ

ИЗУЧЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ

Методические указания к лабораторной работе O-51 по курсу общей физики Под редакцией А. И. Савельевой Москва, 1988

<u>Цель работы</u> - изучение закономерностей взаимодействия *ү*-излучения с веществом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Взаимодействие у -излучения с веществом

Гамма-излучение (а также рентгеновское излучение) - это электромагнитные волны с чрезвычайно малой длиной волны λ . Кванты (фотоны) этих излучений обладают большими значениями энергии $E=hv=hc/\lambda$ и импульса $p=h/\lambda$ (h - постоянная Планка, c - скорость света, ν - частота).

Испускание γ -квантов сопровождает радиоактивный распад в тех случаях; когда образующиеся ядра находятся в возбужденном состоянии. При переходе ядра с верхнего энергетического уровня на нижний излучается γ -квант с энергией, равной разности энергии уровней, между которыми происходит переход. Для конкретного изотопа E имеет одно или несколько дискретных значений в диапазоне от $\sim 10^4$ до $\sim 10^6$ эВ. Большие энергии можно получить с помощью ускорителей элементарных частиц.

Рентгеновское излучение (РИ), образующееся в рентгеновской трубке при торможении быстрых электронов в металлической пластине (аноде), имеет сплошной спектр. Максимальная анергия квантов РИ равна кинетической энергии ускоренного в трубке электрона.

При взаимодействии у-излучения и РИ с веществом происходят следующие основные процессы: эффект Комптона, фотоэффект и рождение пары электрон-позитрон. Все они имеют корпускулярный характер.

<u>Эффект Комптона</u> - упругое рассеяние фотонов на свободных (или слабо связанных атомных) электронах, сопровождающееся увеличением длины волны. Фотон передает часть своей энергии и импульса электрону и изменяет направление движения; уменьшение энергии фотона и означает увеличение длины волны рассеянного излучения.

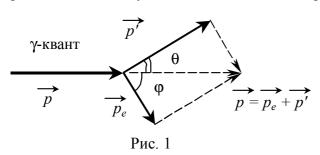


Рис. 1 иллюстрирует закон сохранения импульса при комптон-эффекте: до столкновения электрон покоится; \vec{p} и \vec{p}' - импульсы налетающего и рассеянного фотонов; \vec{p}_e - импульс электрона отдачи; θ - угол рассеяния фотона; ϕ - угол, под которым летит электрон отдачи относительно направления падающего фотона. Совместное

решение уравнений, выражающих законы сохранения энергии и импульса при комптонэффекте, дает для сдвига джига волны формулу Комптона:

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_{\rm C} (1 - \cos \theta). \tag{1}$$

Здесь λ' - длина волны рассеянного излучения, $\lambda_C = h/(mc) = 2,4 \cdot 10^{-12}$ м - комптоновская длина волны электрона (m -масса покоя электрона). Из (1) следует что сдвиг $\Delta\lambda$ не зависит от

длины волны падающего излучения, а определяется лишь углом и максимален при θ =180° (λ_{max} =2 λ_{C}). Однако относительный сдвиг $\Delta\lambda/\lambda$ возрастает с уменьшением λ .

В действительности электроны не свободны, а связаны в атомах. Электрону необходимо сообщить энергию $\geq E_{\rm CB}$, чтобы вырвать его из атома. Величина $E_{\rm CB}$ называется энергией связи электрона. Она возрастает с увеличением зарядового числа Z и уменьшением радиуса орбиты. Если энергия γ -кванта велика по сравнению с $E_{\rm CB}$, рассеяние происходит как на свободных электронах.

<u>Фотоэффект</u> - квантовое явление, при котором фотон поглощается, а его энергия передается электрону. В отличие от комптон-эффекта, при фотоэффекте: а) фотон исчезает; б) процесс происходит на связанных электронах, так как свободный электрон не может поглотить фотон (при этом не могут быть соблюдены одновременно законы сохранения энергии и импульса).

Различают следующие случаи фотоэффекта.

- 1. Внешний фотоэффект испускание электронов твердыми телами и жидкостями в вакуум иди другую среду.
- 2. Внутренний фотоэффект перераспределение электронов по энергетическим состояниям в конденсированной среде, проявляющееся в полупроводниках и диэлектриках в изменении электропроводности среды. Внешний и внутренний фотоэффекты играют важную роль для излучения оптического диапазона.
- 3. При достаточно больших энергиях квантов (γ -излучение, РИ) электроны могут вырываться из внутренних оболочек атома; кинетическая энергия вылетевшего электрона выражается соотношением Эйнштейна: $E_{\text{кин}}$ = $h\nu$ $E_{\text{св}}$

Рождение пары электрон-позитрон происходит в электрическом поле ядра под действием γ -излучения. При этом γ -квант исчезает, а его энергия затрачивается на энергию покоя $(2mc^2)$ и кинетическую энергию электрона и позитрона. В соответствия с законом сохранения полной релятивистской энергии рождение пар возможно при hv>2 mc^2 ≈1 МэВ.

Вероятность того, что γ -квант провзаимодействует с веществом путем того или иного из указанных процессов, зависит от его энергии E и зарядового числа Z вещества. С увеличением E доминируют сначала фотоэффект (особенно для больших Z), затем комптоновское рассеяние (при E \approx 1...4 МэВ для Pb и 0,05...10 МэВ для Al) и, наконец, рождение пар.

Ослабление пучка у-излучения.

Выведем формулу для ослабления параллельного пучка γ -квантов одинаковой энергии. На поглотитель толщиной l падает поток I_0 (число γ -квантов в секунду). Обозначим

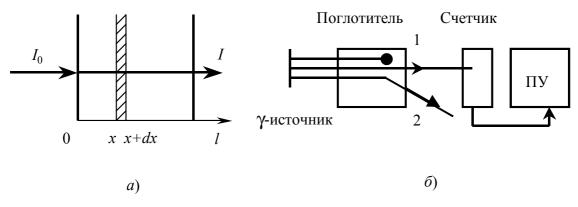
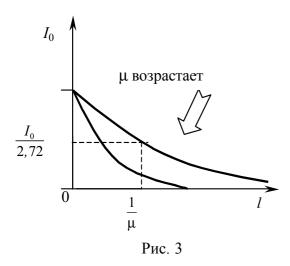


Рис.2

I(x) поток на глубине x. Рассмотрим ослабление потока в слое толщиной dx на глубине x. Имеется некоторая вероятность, что квант провзаимодействует в этом слое и выбудет из пучка, поглотится в результате фотоэффекта или рождения пары (луч 1 на рис. 26) или рассеется при комптоновском взаимодействии (луч 2). В результате поток I(x), состоящий из

большого числа квантов, уменьшится в среднем на величину dI, пропорциональную толщине dx и потоку



$$-dI = \mu I(x)dx \tag{2}$$

где μ =const для данного вещества и E . Интегрируя (2), получим выражение для потока, прошедшего слой толщиной l :

$$I=I_0 \exp(-\mu l) \tag{3}$$

На рис. 3 представлена эта зависимость для различных значений линейного коэффициента ослабления μ . Величина μ измеряется в единицах м¹. Она имеет следующий смысл: в слое толщиной $1/\mu$ поток ослабляется в $e\approx 2,72$ раза.

Для одного и того же вещества, например, воздуха, µ пропорционально плотности р. Поэтому часто удобнее пользоваться массовым коэффициентом ослабления:

$$\mu_{\rm M} = \mu/\rho \tag{4}$$

Тогда из (3) получаем

$$I = I_0 \exp(-\mu_{\scriptscriptstyle M} l \rho), \tag{5}$$

Где lр— «толщина» поглотителя, кг/м²; $\mu_{\rm M}$ — массовый коэффициент ослабления, м²/кг. На рис. 4 представлены теоретические зависимости $\mu_{\rm M}$ от Е для свинца и алюминия. Не показанные на рис. 4 зависимости для элементов с промежуточными значениями Z (между Al

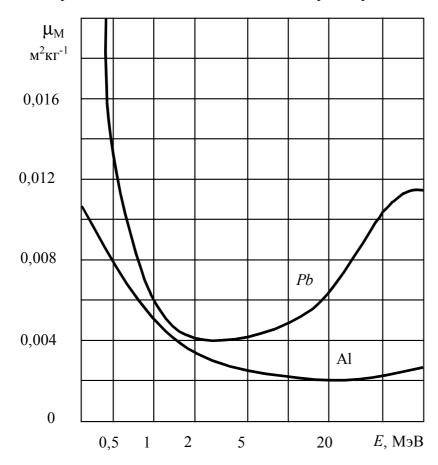


Рис.4

и Рв) располагаются между приведенными кривыми.

На рис. 4 видна интересная особенность, которую можно проверить в данной работе. Для $E \approx 1...4$ МэВ $\mu_{\text{м}}$ почти не зависит от Z. Объяснение состоит в том, что в этом энергетическом интервале преобладает комптоновское рассеяние, вероятность которого пропорциональна числу атомных электронов на пути кванта, а число электронов пропорционально толщине поглотителя ρl . Поэтому поглотители из различных веществ, но с одинаковым значением ρl имеют примерно одинаковое ослабление.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Методика измерений.

Схема опыта представлена на рис. 26. Гамма-излучение с энергией примерно 1,2 МэВ испускается при распаде изотопа ⁶⁰Co. Сцинтилляционный счетчик регистрирует отдельные у-кванты, вырабатывая электрический импульс. Импульсы считаются пересчетным устройством (ПУ). Пусть за время t появилось N' импульсов. Средней скоростью счета называется отношение n'=N'/t. Если радиоактивный препарат убрать, то скорость счета уменьшается до величины n_{ϕ} называемой фоном счетчика. Фон обусловлен частицами космического излучения, естественной радиоактивностью и процессами в самом счетчике. Разность n=n'-n_d есть скорость счета излучения исследуемого препарата. пропорциональна потоку у-квантов:

$$n = aI \tag{6}$$

Подставляя (6) в (3), получим

$$n = n_0 \exp(-\mu l), \tag{7}$$

где n_0 и n - скорость счета без поглотителя и с поглотителем толщиной l. После логарифмирования (7) имеем

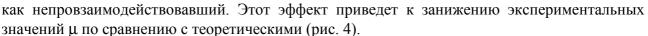
$$ln(n/n_0) = -\mu l \tag{8}$$

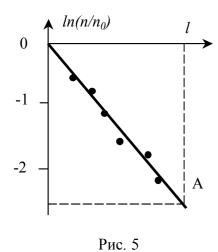
Если, измерив скорость счета без поглотителя и для различных толщин l, построить графическую зависимость $ln(n/n_0)$ как функцию l, то можно проверить экспоненциальный закон ослабления (3) и определить численное значение μ для данного вещества. В соответствии с (8) экспериментальные точки должны ложиться на прямую (рис. 5). Из наклона прямой можно получить численное значение μ :

$$\mu = -\ln(n/n_0)/l \tag{9}$$

подставив в (9) значения l и $ln(n/n_0)$ для любой точки A, лежащей на прямой (рис. 5).

Результат измерения μ в некоторой степени зависит от геометрических условий опыта. Если γ -квант рассеялся на малый угол и попал в счетчик, то он будет восприниматься





Сцинтилляционный счетчик

В действием некоторых веществах, называемых сцинтилляторами, ПОД ионизирующих быстрых частиц сцинтилляции возникают световые вспышки (разновидность люминесценции). Для регистрации γ -излучения используют кристаллы NaI(Tl) размером несколько сантиметров.

 γ -квант в результате взаимодействия с веществом сцинтиллятора (эффект Комптона, фотоэффект, рождение e^-e^+ пары) передает энергию электрону (и позитрону); сцинтилляция производится заряженной частицей. Устройство счетчика показано на рис. 6.

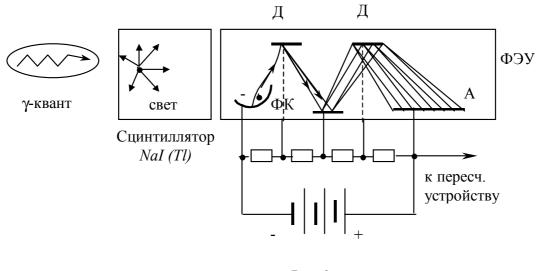
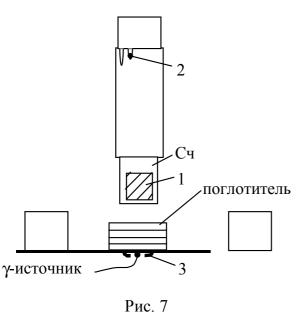


Рис.6

Вспышка света регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), сочетающего в одном электровакуумном приборе фотоэлемент и усилитель тока. ФЭУ состоит из фотокатода (ФК), анода (А) и нескольких промежуточных электродов - динодов (Д). С помощью высоковольтного источника и делителя напряжения на диноды и анод подается положительный потенциал. По мере удаления от ФК потенциал каждого последующего электрода возрастает примерно на 100 В. Электроны, испускаемые фотокатодом под действием света, ускоряются электрическим полем и выбивают из первого динода вторичные электроны, число которых в δ раз больше числа первичных электронов. Этот процесс повторяется на каждом диноде и приводит к значительному усилению тока (например, в $\delta^{\kappa} = 2 < 10^6$ раз для $\delta = 5$ и $\kappa = 9$ динодов). Лавина электронов достигает анода в создает в его цепи значительный электрический импульсы считаются пересчетным устройством.

Описание лабораторной установки.



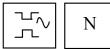
Установка (рис. 7) включает в себя счетчик у-излучения (Сч), пересчетное устройство (ПУ), источник питания счетчика (ИП). Сцинтиллятор 1 находится в нижней части светонепроницаемого кожуха. Счетчик можно перемещать по вертикали; рабочим является верхнее положение, когда выступ 2 входит в короткую прорезь.

Источник у-излучения представляет собой герметичную стальную ампулу, внутри которой находится радиоактивный препарат незначительной активности. Направляющие 3 служат да установки источника в рабочее положение.

К установке прилагаются наборы пластин алюминия, меди (латуни) и свинца.

Выполнение эксперимента.

1. Ознакомиться с установкой (рис. 7). Включить СЕТЬ источника питания и пересчетного устройства. В рабочем положении ПУ должны быть утоплены клавиши:



НЕПРЕРЫВНО-ОДНОКРАТНО и одна из клавиш экспозиции.

2. Установить счетчик в верхнем положении (выступ 2 входит в короткую прорезь).

ВНИМАНИЕ! За кабель счетчика не тянуть!

- 3. Пока установка прогревается (3 мин), выполнить несколько пробных измерений фона с экспозицией 10 с (нажать клавишу 10) Управление ПУ производится последовательным нажатием клавши СБРОС и ПУСК. По окончании заданного времени, когда лампочка СЧЕТ погаснет, считать с индикатора число зарегистрированных импульсов ($N_{\phi} \approx 20...50$)
- 4. Утопить клавишу 100, измерить три раза фон с экспозицией 100 с, результаты записать в табл. 1.
- 5. Получить у лаборанта у-источник. Установить его в рабочее положение (по направляющим 3 до упора),
- 6. Без поглотителя измерить три раза число импульсов и записать результаты в табл. 1.

Таблица 1

				таолица т	
Измерения	Число импульсов	Суммарное число	Скорость счета, имп/с		
	за 100с	импульсов в трех			
		измерениях			
Фона	1. 2.	$N_{\phi}=$	$n_{\phi}=$		
	3.	J			
Без	1.)			
поглотителя	2.	$N_0=$	n' ₀ =	$n_0=n'_0-n_{\phi}$	
	3.	J			

Таблица 2

Поглотитель	Толщина	l	N'	Обработка			
	пластины			n'	$n=n'-n_{\phi}$	n/n_0	$ln(n/n_0)$

- 7. Для алюминия измерить число импульсов N′ (по одному измерению за 100 с) для различной толщины поглотителя l (изменять l с шагом 15...20 мм до 80...90 мм). Толщину отдельных пластин измерить штангенциркулем. Результаты измерений записать в таблицу 2.
- 8. Повторить измерения п. 7 для одного материала с большим Z: меди (латуни) с шагом 10...12 мм до 60...70 мм или свинца с шагом 4...6 мм до ~ 40 мм,
- 9. Выключить СЕТЬ приборов, сдать у -источник, убрать поглотитель в коробку.

Обработка и анализ результатов измерений.

- 1. Построить графическую зависимость $ln(n/n_0)$ от l (на одном графике для двух поглотителей). Через отчетливо изображенные экспериментальные точки и начало координат провести для каждого материала прямую так, чтобы отклонения точек от нее были наименьшими (рис. 5).
- 2. Сделать вывод, согласуются ли результаты опыта с экспоненциальной зависимостью (3).
- 3. Найти значения μ , используя построенный график и формулу (9). Выразить μ в единицах M^{-1} , результат записать в табл. 3.
- 4. По формуле (4) вычислить $\mu_{\rm M}$ и записать результаты в табл. 3 (ρ в единицах 10^3 кг/м³ принять равным 2.8 для алюминия; 8.5 для латуни; 8.9 для Cu и 11,3 для Pb).

Таблица 3

Поглотитель	Экс	Теория	
	μ, м ⁻¹	$\mu_{\rm M} \pm \Delta \mu_{\rm M}$, ${\rm M}^2/{\rm K}\Gamma$	$\mu_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$, м 2 /кг

5. Оценить погрешность измерения значений μ_{M} . Из (4), (9) получаем

$$\mu_{M} = -ln(n/n_0)/(\rho l)$$
.

По правилам вычисления относительной средней квадратичной погрешности косвенных измерений имеем

$$\left(\frac{\Delta \mu_{M}}{\mu_{M}}\right)^{2} = \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta \ln(n/n_{0})}{\ln(n/n_{0})}\right)^{2} \tag{10}$$

где Δl - средняя квадратичная погрешность измерения толщины поглотителя. Последнее слагаемое в (10), обусловленное статистической природой радиоактивного распада, в данной работе невелико и им можно пренебречь. Тогда из (10) получим

$$\Delta \mu_{M} = \mu_{M} \sqrt{\left(\Delta l / l\right)^{2} + \left(\Delta \rho / \rho\right)^{2}}$$
(11)

Вычислить погрешность по формуле (11), приняв $\Delta \rho / \rho = 0.01$ (разброс плотности различных марок металла). Погрешность Δl оценить самостоятельно.

6. Пользуясь рис. 4, определить теоретические значения $\mu_{\rm M}$ для материалов данной работы; записать результаты в табл. 3. Объяснить возможное расхождение эксперимента с теорией.

Контрольные вопросы

- 1. Опишите процессы взаимодействия у-излучения с веществом.
- 2. Как изменяется поток у-квантов с толщиной поглотителя?
- 3. Какой физический смысл имеют величины μ и μ_{M} , как они зависят от Z и E ?
- 4. Почему при $E \approx 1...4$ МэВ различные поглотители имеют близкие значения $\mu_{\rm M}$?
- 5. Объяснить причину расхождения теоретических и экспериментальных значений $\mu_{\rm M}$

Содержание отчета

Отчет должен содержать краткий конспект теоретической части, схему опыта и экспериментальные данные (таблицы 1...3 и график).

Литература

Детлаф А. А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа. - 1979. - Т. 3. - 511 с.